INFLUENCE OF THE BUNCHER ON BEAM INTENSITY AND PHASE WIDTH IN THE JAEA AVF CYCLOTRON

Nobumasa Miyawaki ^{#,A)}, Satoshi Kurashima ^{A)}, Hirotsugu Kashiwagi ^{A)}, Susumu Okumura ^{A)} ^{A)} Takasaki Advanced Radiation Research Institute, Japan Atomic Energy Research Agency

1233 Watanuki, Takasaki, Gunma 370-1292

Abstract

Measurements of the beam currents and the beam intensity distributions in acceleration phases were carried out to investigate the influence of external beam bunching on the beam intensity and the beam phase width for each acceleration harmonic mode (H=1, 2) in the JAEA AVF cyclotron. Although the injection efficiencies of the H=2 beam with and without the buncher were higher than those of the H=1 beam, the buncher efficiency of the H=2 beam was lower than that of the H=1 beam because of the phase bunching effect. Using the buncher, the peak intensities of the beams of both H=1 and H=2 were increased by up to several times but the full width of the beam phase were nearly equal to those without using it. The reduction of the full width of the beam phase was unaffected by the buncher even with parameters to maximize the beam current.

JAEA AVF サイクロトロンのビーム強度と位相幅に対する バンチャーの影響

1. はじめに

原子力機構 AVF サイクロトロンでは、微小領域 でのイオンビームによる生物学的影響の研究や材料 科学の研究のために、1µm 以下のビーム径及び照準 位置精度を有する数百 MeV 級重イオンマイクロ ビームの形成¹¹を行っている。マイクロビーム形成 では、4 連四重極電磁石によるビーム集束方式を用 いるため、集束電磁石でのビーム集束で問題となる 色収差を低減する必要がある。これに必要とする 10⁻⁴ 台前半のビームエネルギー幅に近づけるために、 加速 RF に対してビームの位相幅を可能な限り狭く しなければならない^[2]。一方、マイクロビームライ ンの像の縮小率が5 であるため、サイクロトロンか ら輸送されたビームの断面積に比べて集束電磁石前 のオブジェクトスリットで制限する割合が大きい。 従って、サイクロトロンから十分な量のビームを取 出す必要がある。

サイクロトロンの加速ビーム電流を増加するため に、入射ビームライン上に設置されたバンチャーを 通常用いる。バンチャーは正弦波等の電圧を発生さ せてビームに速度差を生じさせ、サイクロトロンの 内部で加速可能な RF 位相内にビームを圧縮させる。 これを効果的に使用するため、サイクロトロンの内 部でのビーム位相の影響を詳細に評価する必要があ る。

従来のビーム位相に対する強度分布(ビーム位相 分布)の測定は、空間的な制約や磁場や放射線等の 計測環境の問題によって、サイクロトロン取出し後 ビームライン上で行われてきた。この場合、狭い間 隙を持つデフレクター電極などの取出し機器でビー ムを損失するため、制限された測定結果しか得られ ない。それに対して現在では、サイクロトロン内部 で半径方向に挿入されるプローブにプラスチックシ ンチレーターを取り付けることで、取出し機器によ るビーム損失の影響を受けずにビーム位相分布の測 定が可能となった^[3]。このプローブを用いて、サイ クロトロン内部のビーム軌道を決めるスリット位置 毎やバンチャーの RF の相対位相毎にビーム位相分 布を測定した結果、加速ハーモニックによって分布 中のピークの位相の変化が異なった^[4]。特に、サイ クロトロンで加速するバンチの RF 位相を決めるバ ンチャーの RF の相対位相毎のビーム位相分布の測 定では、H=1 の場合はバンチャーの位相変化に対し てピークの位相も大きく変化するが、H=2の場合は ほとんど変化が無いという結果が得られ、位相バン チング効果^[5]が生じていることがわかった。一方、 マイクロビーム形成のようにビーム電流が最大とな る調整をしたバンチャーを用いた場合のビーム位相 への影響についての知見は得られていない。

現在マイクロビーム形成は、H=2のビームに対して 1µm 以下まで集束が確認されているが、H=1の ビームに対してはまだ形成できていない。そこで、 H=2とH=1のそれぞれの場合に対して、サイクロト ロンの入射前後でのビーム電流を測定し、さらにバ ンチャーの有無によるビーム位相分布の変化を測定 することで、マイクロビーム形成で必要とするビー ム電流の増加とビーム位相の狭小化に対するバン チャーの影響を調べた。

2. 測定条件

ビーム電流と位相分布の測定では、サイクロトロンの半径方向の磁場分布は、±3RF 度以内の等時性磁場を保つようにトリムコイルへの励磁電流を調整し、バンチャーのパラメーターはビーム電流が最大になるように調整した。

ビーム電流測定のビーム条件は、加速ハーモニッ

ク毎に、H=1 は 100MeV ⁴He²⁺と 45MeV H⁺、H=2 は 260MeV ²⁰Ne⁷⁺と 220MeV ¹²C⁵⁺を代表例として用い た。測定は、サイクロトロン入射直前のビーム診断 ポート(IS5)のファラデーカップとサイクロトロン取 出し直前の位置にあるプローブ(Mag0)で行い、バン チャーの有無による Mag0 の電流と IS5 の電流の比 である入射効率を調べた。

ビーム位相分布測定のビーム条件は、H=1 では 100MeV 4 He²⁺と H=2 では 260MeV 20 Ne⁷⁺を用いた。 測定は、サイクロトロン内部のプローブに取り付け たプラスチックシンチレーター(BC400, Saint-Gobain) で行った。サイクロトロンでは、半径の二乗に比例 してエネルギーが増加するため、取出し半径に近い ほどシンチレーターの発光強度が増加して S/N が良 くなるため、プローブを取出し半径付近に設定した。 一方、シンチレーターからの発光は、磁場の影響を 避けるために大気中のプローブの他端に設置した光 電子増倍管(H6533, 浜松ホトニクス)へ、光ケーブル によって伝達された。光電子増倍管の信号は、 ファーストタイミングプリアンプ(VT120, Ortec)で増 幅された後、コンスタント・フラクション・ディス クリミネータ(CFD) (935, Ortec)で閾値以上の信号の み選別され、その信号をピコセカンド・タイムアナ ライザー(p-TA) (9308-PCI, Ortec)のスタートパルスと した。一方、サイクロトロンの RF ピックアップ電 極から得られた信号は CFD を通して p-TA のストッ プパルスとし、この時間間隔を PC 上で時間スペク トルとして記録した。

3. 測定結果

3.1 ビーム電流測定

JAEA AVF サイクロトロンのバンチャーによる ビームのバンチングは、計算において H=1 と H=2 とも同じである^[6]。そのため、バンチャーを用いた (BB on)時の入射効率とバンチャーを用いない (BB off)時と比べて、H による変化が無いと想定 される。 表1に、H=1とH=2のそれぞれの場合に対して、 バンチャーの有無に対するビーム電流と入射効率を 示す。入射効率はバンチャーの有無に関係なく、 H=2がH=1より高い。特に、BB off の場合、H=2が H=1より約 1.4~2.2 倍も高くなった。一方、バン チャーの有無に対する入射効率の比(バンチャー効 率)は、計算上 H=1と H=2とも同じはずであるが、 H=1が最も大きい結果となった。H=2は BB off でも すでに入射効率が高いため、バンチャー効率は、結 果として H=1より悪くなった。

3.2 ビーム位相分布測定

BB off の場合、時間的に均一なビームをサイク ロトロンに入射するので、サイクロトロン内部の ビーム電流は位相アクセプタンスに依存すると考え られる。しかし、前節のように H=2 が H=1 の約 1.4 倍以上まで位相アクセプタンスが大きいことは、考 え難い。また、ビーム電流測定では、サイクロトロ ンへの入射後のビームの時間変化の影響も有り得る。 従って、サイクロトロン内部でのビーム位相分布の 測定は必要である。バンチャーの有無に対するビー ム位相分布の測定結果を図 1 の(a)H=1 と(b)H=2 にそ れぞれ示す。

BB on、off の両方とも、入射効率の高い H=2 の位 相幅は約 30RF 度と H=1 とほぼ等しい。一方で、前 節の結果から H=2 の入射効率は H=1 より約 1.4 倍以 上大きいため、サイクロトロンへの入射後にバンチ ングされている。従って、H=2 の条件では位相バン チング効果が生じている。

測定されたビーム位相分布において BB on の場合 のピークの強度は、BB off の場合のそれと比べて数 倍高くなったが、ビーム位相の全体の幅はほとんど 変わらなかった。従って、ビーム電流が最大になる 様に調整したバンチャーは、サイクロトロンの位相 アクセプタンスの範囲にわたってビーム強度を高く するが、ビーム位相の全幅に対して影響を与えない ことがわかった。

加速 ハーモニック	ビーム 条件	IS5 (μA) (a)	バンチャー BB	Mag0 (μA) (b)	入射効率 (%) (b/a)	バンチャー効率
H=1	$^{4}\text{He}^{2+}$	3.27	on	1.48	45.26	4.63
	100MeV		off	0.32	9.79	
	H^{+}	7.11	on	3.00	42.19	3.66
	45MeV		off	0.82	11.53	
H=2	²⁰ Ne ⁷⁺	2.93	on	1.52	51.88	3.17
	260MeV		off	0.48	16.38	
	$^{12}C^{5+}$	0.66	on	0.41	62.12	2.93
	220MeV		off	0.14	21.21	

表1:測定されたビーム電流と入射効率、バンチャー効率



図 1: サイクロトロン内部のビーム位相分布の測定 結果。バンチャーの有無に対して(a) 100MeV ⁴He²⁺(H=1)と(b) 260MeV ²⁰Ne⁷⁺(H=2)の条件で行っ た。横軸(相対位相)は1 チャンネル当たり 2.441ps 幅を加速 RF 位相に変換し、縦軸(ビーム強 度)は 2.441ps 幅のチャンネル当たりのカウントを 総カウント数から割り、BB on の時の最大値からの 割合である。

4. まとめと考察

JAEA AVF サイクロトロンにおいて、H=1、2の 条件でビーム電流と位相幅に対するバンチャーの影 響をビーム電流測定とビーム位相分布測定によって 調べた。入射効率は、バンチャーの有無に関係なく、 H=2 が高く、特にバンチャー無しでも高いため、位相 バンチング効果が生じたと考えられる。一方、バン チャーによるビーム電流の増加割合であるバン チャー効率は、計算上 H=1 と H=2 とも同じだが、 この位相バンチング効果によって、H=2 では見掛け 上低くなることがわかった。ビーム位相分布測定で は、ビーム位相分布のピーク強度はバンチャーに よって増加するが、全幅への影響はほとんどなく、 位相アクセプタンスまで広がっていることを確認し た。バンチャーで増加したピークの位相は、H=1 では分 布中の一部分に対して、H=2 では全体が増加した。 こ れは、[4]の報告において、H=1 では BB 位相によっ てピーク位相が変化したが、H=2 では位相バンチング によってピーク位相は BB 位相で変化しなかったこ とから、この差が生じたと考えられる。従って、バン チャーはビーム位相の全幅には影響を与えないので、 ビーム位相の全幅を狭くするためには、H=1と2の 両方とも、ビーム位相分布のこのピーク位相部分を サイクロトロン内部のスリットで制限して取出す必 要があるが、ピーク位相が変化しない H=2 の場合、 特定のビーム位相をスリットで制限することは容易 である。これらの結果から、JAEA AVF サイクロト ロンにおいて H=2 の条件でマイクロビーム形成が可 能となった要因の一つと考えられる。

参考文献

- [1] M. Oikawa, et al., Nucl. Instrum. Methods B 260 (2007) 85
- [2] M. Fukuda, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B210 (2003) 33
- [3] N. Miyawaki, et al., Proc. 3rd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 31st Linear Accelerator Meeting in Japan, 913 (2006)
- [4] N. Miyawaki, et al., Proc. 6th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 183 (2009)
- [5] N. Miyawaki, et al., Nucl. Instrum. Methods A 636 (2011) 41
- [6] K. Arakawa, et al., JAEA-Technology 2008-024